



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H327

对应国外型号
BC327

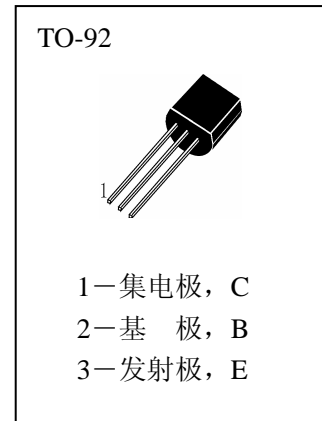
■ 主要用途

音频放大、驱动级。

■ 外形图及引脚排列

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg}	— 贮存温度	-55~150 $^\circ\text{C}$
T_j	— 结温	150 $^\circ\text{C}$
P_C	— 集电极耗散功率	625mW
V_{CBO}	— 集电极—基极电压	-50V
V_{CEO}	— 集电极—发射极电压	-45V
V_{EBO}	— 发射极—基极电压	-5V
I_C	— 集电极电流	-0.5A



■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-50			V	$I_C=-100\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-45			V	$I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-100\mu\text{A}$, $I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	100		600		$V_{CE}=-1\text{V}$, $I_C=-100\text{mA}$
$H_{FE}(2)$		40				$V_{CE}=-1\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.7	V	$I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$
V_{BE}	基极—发射极电压			-1.2	V	$V_{CE}=-1\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	$V_{CB}=-20\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-10	μA	$V_{EB}=-5\text{V}$, $I_C=0$
f_T	特征频率		100		MHz	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-10\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		8			$V_{CB}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$

■ 分档及其标志

16	25	40
100—250	160—400	250—600



■ 特性曲线

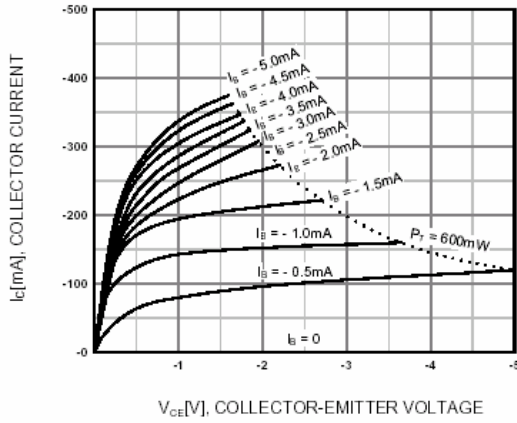


Figure 1. Static Characteristic

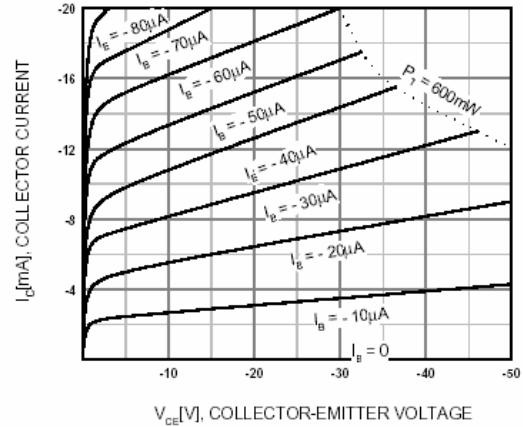


Figure 2. Static Characteristic

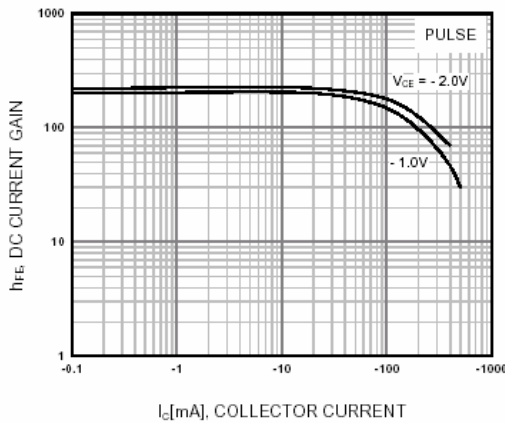


Figure 3. DC current Gain

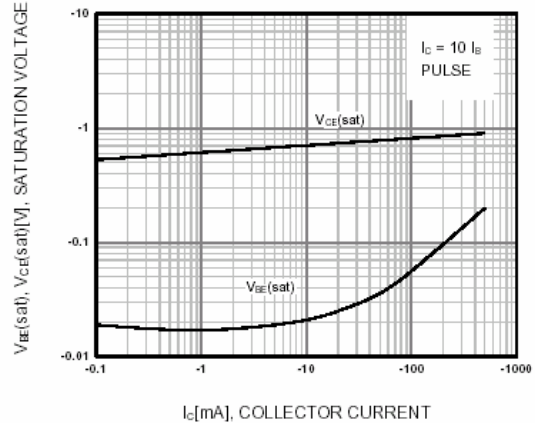


Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

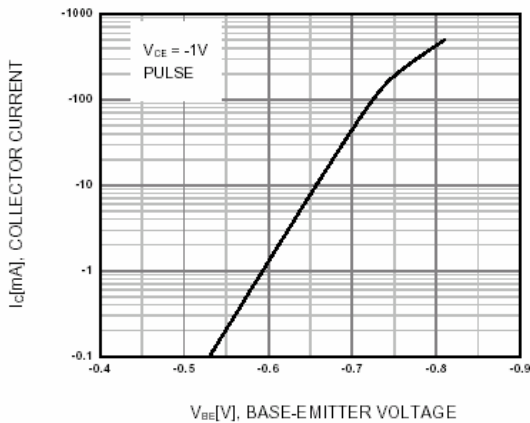


Figure 5. Base-Emitter On Voltage

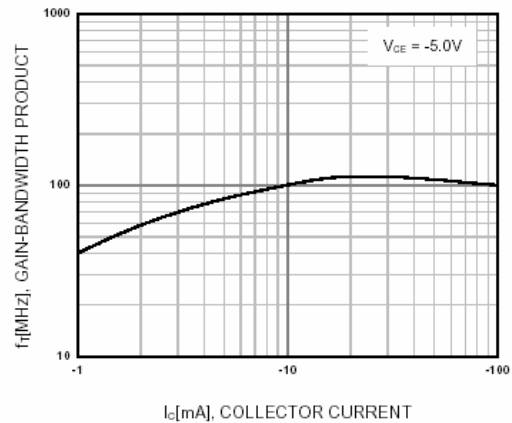


Figure 6. Gain Bandwidth Product